

60 MeV 電子加速器を用いた光核反応による放射性同位体製造のための 照射システムの評価

EVALUATION OF THE IRRADIATION SYSTEM FOR RADIOACTIVE ISOTOPE PRODUCTION VIA PHOTONUCLEAR REACTION USING A 60 MEV ELECTRON LINAC

高橋 健^{#, A)}, 菊永英寿^{A)}, 塚田 暁^{A)}, 武藤俊哉^{A)}, 柏木 茂^{A)},
須田利美^{A)}, 南部 健一^{A)}, 長澤 育郎^{A)}, 日出 富士雄^{A)}, 濱 広幸^{A)}
Ken Takahashi^{#, A)}, Hidetoshi Kikunaga^{A)}, Kyo Tsukada^{A)}, Toshiya Muto^{A)}, Shigeru Kashiwagi^{A)},
Toshimi Suda^{A)}, Kenichi Nanbu^{A)}, Ikuro Nagasawa^{A)}, Fujio Hinode^{A)}, and Hiroyuki Hama^{A)}

^{A)} Research Center for Electron Photon Science (ELPH), Tohoku University

Abstract

We have produced radioactive isotope (RI) via photonuclear reaction using a 60-MeV electron linac at Research Center for Electron Photon Science, Tohoku University. Although electron accelerator based RI production is practiced in many facility, beam parameters and irradiation condition such as converter material and distance between converter and target are unique in each facility. We have studied the size and divergence of bremsstrahlung γ -ray at our target position, and estimated the photon flux of our irradiation system employing equivalent quanta in yield. This paper reports these parameters of our irradiation system.

1. はじめに

東北大学電子光物理学研究センターでは電子ビームを用いた光核反応による放射性同位体製造を行っている。チタン箔を通して大気中に取り出した電子ビームをタングステンや白金に入射して生成した制動放射線を標的に照射する[1][2]。課題として照射効率の向上や照射室内の放射化軽減、標的への熱負荷低減が求められている。しかし、照射効率は装置依存性が高いため、照射システム全体の高度化を図るには、電子ビームパラメータや現在使用しているコンバータと標的の構成で制動放射線の特徴を十分に把握する必要がある。その第一歩としてビーム軸上に設置したニッケル箔標的を照射して、 $^{58}\text{Ni}(\gamma, n)^{57}\text{Ni}$ で生成した標的中の ^{57}Ni 放射能強度分布を測定した。測定したプロファイルから、標的上での空間的なサイズや制動放射線の角度広がりを評価した。ま

た、照射位置での制動放射線を定量的に評価するため、照射をよく再現した GENAT4 を用いて光子当量 (equivalent quanta) に換算したフラックスを導出した。

2. 60 MeV 大強度電子加速器

電子ビームを 80 kV 電子銃から 300pps で引き出した後、プリバンチャー、バンチャー、1m 加速器管 8 本で、最大 60 MeV まで加速する。ビームエネルギーは 10 MeV から 60 MeV の間で調整が可能である。加速後はビーム診断部と 90° ビーム偏向部を経て、照射室にビームを輸送する(Fig.1)。これまで RI 製造で最も利用の多い 50 MeV の運転パラメータで Q-Scan 法を用いた測定からビームエミッタンスはおおよそ 80π mm-mrad と求められている[3]。

3. ^{57}Ni 放射能強度分布計測

3.1 RI 製造用照射システム

RI 製造で用いる照射システムでは、厚み 2 mm のコンバータと石英管に封入した標的を冷却水が循環するステンレス容器内に配置している(Fig.2)。コンバータと標的の距離は 3 cm としている。標的ポートの上流には、照射中のビーム照射位置モニタ用の厚み 0.5 mm の BeO スクリーンとビームを真空容器から大気に取り出すフランジに取り付けた厚み 50 μm のチタン箔で構成している。

3.2 プロファイル測定用照射システム

巨大共鳴のエネルギー領域に光核反応断面積を持つニッケルを標的に用いた(Fig.3)。プロファイル測定用のシステムは RI 製造時の制動放射線空間プロファイルを再現するため、コンバータと標的を同様の位置に配置した(Fig.4)。ニッケル箔の厚みは 10 μm で、角度広がり

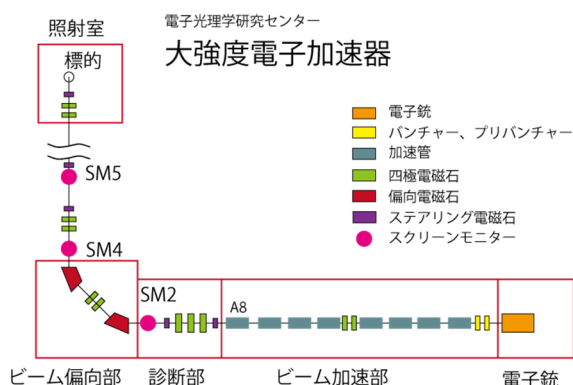


Figure 1: A scheme of 60 MeV electron linac.

[#] ken_takahashi@lns.tohoku.ac.jp



Figure 3: ⁵⁸Ni (, n) cross section in giant resonance region [4].

Figure 2: A scheme of current irradiation system.

G" FéG FiG Fû FèGYQG?Gy'éG" †\$x Fp 3 Som Fp 3.4 ⁵⁷Ni : U+ I Ø
)*(FûG vG ÚFáFiF1GAG•G^GŠGM è ¥FÛG Fp D . : U)z
 G" * öFéG FiG FûF, !. U pFpGaGŠGn)*(GpGYGM#ÝGöGxGx (xG" "G FiG FûF, GYGQG?Gy'éG" A Ê"gfû)
 G0GGG=GxGŠG•Fý ¥FçFöFÖG F1GzGŠGy VG" .Fß Z4F V FÜGA 284F V FÜGA
 G•G^GŠGMFøGYGQG?GyG"0¿*(FçFöF, GaGŠGn3H V FÜG FèG 1377.63 keV
 S BFøFçFiF1 1377.63 keV)zFp : & "áFý 81.7%F,)zFp è
 "áFý 0.175%F÷FÖG F1
 3.3 GaGŠGn1* Z Fñi)z ;Fp 8 B 'é"&FiG FiG Fp : U+ I ØG"2ŠFç œG FèFö –FpGYGQ
 !. U SFû †\$x Fp)*(F÷GaGŠGnGCG2GHFÜ qG `FáFpFpG G2Gy'éFûFöFöFö : U+ I ØG" ÓG F, GAG•G^GŠGM m SFû
 G FÖFû1* ZG"/œFóFiF11* BèD GGG=GxGŠG•G" ¥FçFçFiGYGQG?Gy'é=91 kBçF, GAG•G^GŠGM W vFpGYGQ
 Ge{GcG/G2Gy #Ý! UGEGGTGnG"GaGŠGn3H V FÜG FèG 1879.ü.1.78 MBq
 Fö! UG"/œFóFiF1GAG•G^GŠGMFp í 7G"*f ÖFçFöF, GaGŠGn F÷FçFçFiF1
 G6G[GyG<GŠ MeV, 1'7Á v 41.6 A F÷75 (! UFçFi
 (Table 1F1 >à>Ú>ì D . : U)zFp"i ö>ì

Table 1: Experiment Parameters

7Á ÊGaGŠGn	
G6G[GyG<GŠ	50 MeV
1'7Á v	41.6 A
GbGŠG=7Á v	100 mA
GaGŠGn)PG 3ÉFç	100 pps
G_GyGG œ	4 s
0d A iG6GmGQGGMG•GŠG 0mm.mrad	
GYGQG?Gy'é †\$x	
GMGŠG@GQGV	⁵⁸ Ni
g"g	Foil
LG	10 m
Ñ ~ š	68%
: U ö) –(ò	⁵⁷ Ni
ö ‡	35.6 h
GMG•G>GGGTG•GAG•G^GŠGM	
LG	2 mm
& Ø	19.25 g/cm ³

4.1 '56ë (xFpGCG2GHFø D . : U)zFp\$Í S0...
)G FçFi'é"&Fp : U+ 5 FÛG È 1Fø ¶%\$ %œ ¥
 Fp'56ë (xG" _ FçFiF1GAG•G^GŠGM%\$1#2.35, 2.00
 mmFRI 0 4 iFp †\$x)*(F÷ 3.85, 3.61 mñ, GAG•G^GŠGM
 Fp6 cm W vF÷5.69, 4.94 mñF÷FÖFöF3FÜFp I Ø (x
 FpGCG2GHFÜG "G G Fi D . : U)zFp\$Í S0...FýFiG FiG
 54 mrad (È 1)F49 mrad (¶%\$ F÷FÖFóFiF1
 Ö ‹F, ° UFéG GaGŠGnG_GwGoGŠGMFø#Ö BFçFi D . : U
)zFpöø €G"G G ÁG FÜFûFçFöFöFßF1
 4.2 †\$xG Fp! U "á
 3û –HRI 0 4 Fû QG G G GAG•G^GŠGMFöFö vFp
 : U+ I Ø (xFÛGaGŠGnFû PFçFö3H P&àFø ì FçFöF,
 ±31 Fp(VF÷' (FçFiF1 È 1Fp'56ë (xFÛG p ° -1
 cmFp(VFp : U+ I ØFý ² /FpFÛG Fí 57%Fø ÓG G G

Figure 4: A scheme of irradiation system for profile measurement.

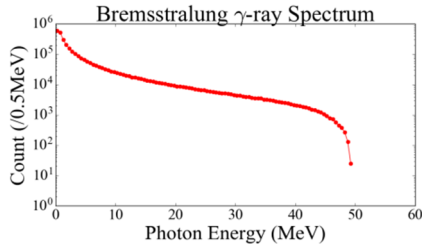


Figure 5: Spectrum of Bremsstrahlung γ -ray by GEANT4 simulation.

た。

5. 光子束

5.1 生成放射エネルギー

生成された放射能の見積もりには制動放射線のスペクトルと (γ, n) 反応の励起関数が必要である。今、照射終了時の生成放射エネルギーを A_0 、ターゲット原子数を N_t 、ビーム電流を N_e 、ビームエネルギーを E_0 、制動放射線のエネルギーを k 、照射効率を ε 、制動放射線の強度係数を f 、規格化された制動放射線のスペクトルを $\varphi(k, E_0)$ 、励起関数を $\sigma(k)$ 、壊変定数を λ 、照射時間を t 、生成収率を $Y(E_0)$ とした時、生成放射エネルギー A_0 は

$$A_0 = \varepsilon N_t N_e f \int_0^{E_0} \varphi(k, E_0) \sigma(k) dk \cdot (1 - e^{-\lambda t}) \quad (1)$$

$$= \varepsilon N_t N_e f Y(E_0) (1 - e^{-\lambda t}) \quad (2)$$

と表せる。ここでは φ は

$$(1/E_0) \int_0^{E_0} k \cdot \varphi(k, E_0) dk = 1 \quad (3)$$

として規格化した (Equivalent quanta)。

5.2 ^{57}Ni 生成放射エネルギー (GEANT4)

プロファイル測定と同様のジオメトリで GEANT4 のシミュレーションを行った。GEANT4 は ^{57}Ni 放射能強度分布計測を通して得られた空間分布をよく再現していた[6]。シミュレーションで得られた制動放射線スペクトルを Fig.5 に示す。ニッケル箔#3 の位置で、入射電子 100 万個あたりの制動放射線による ^{57}Ni 生成量と、virtual photon flux による ^{57}Ni 生成量を Fig.6 に示す。Virtual photon は制動放射線と比べて生成への寄与が十分小さい。

Table 1 の条件を考慮すると、シミュレーションより予想される生成放射エネルギーは 1.86 MBq であり、3.4 で実測した放射エネルギー 1.79 MBq とよく合うことから、GEANT4 は照射をよく再現していると考えられる。

5.3 光子束

ビームエネルギー 50 MeV、タングステン厚み 2 mm、 ^{58}Ni 標的のとき、Fig.5 のスペクトラムと(3)式から $f = 0.33$ と求められた。当センターの RI 製造で利用の多いビーム

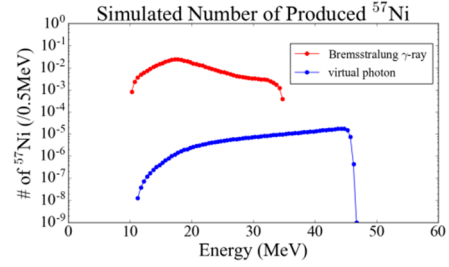


Figure 6: Simulated number of produced ^{57}Ni at nickel foil #3 by Bremsstrahlung γ -ray (red) and by virtual photon (blue). Simulated number of electron is 1 million.

エネルギー 50 MeV、平均電流 120 μA で照射したとき、十分大きい標的に対して光子束は $N_e f = 2.4\text{E}14[\text{eq.} \cdot \text{q.} \cdot \text{s}^{-1}]$ と求められる。

5.4 照射システムの評価

(2)式においてビームエネルギー、ビーム電流、標的核種、照射時間は任意の値であり、RI 製造施設から照射効率 ε を提供されることで、利用者は生成放射エネルギーを見積もることができる。当センター RI 製造システムで標準的な構成として、コンバータ 3 cm 下流に $\Phi 1$ cm の標的を置いた場合、照射効率 ε が 57%であることから $1.4\text{E}14[\text{eq.} \cdot \text{q.} \cdot \text{s}^{-1}]$ と求められた。

今回、実験およびシミュレーションの比較から ε, f を求めることができた。この ε, f が照射セットアップ固有の値、すなわちどの核反応でも共通の値であれば、 $Y(E_0)$ のデータから当センターでの生成放射エネルギーを簡単に見積もることができる。今後、別の標的を用いて、この見積もりが妥当かどうか確認する予定である。

6. まとめ

東北大学電子光理学研究センターでは 60 MeV 電子加速器を用いた光核反応による RI 製造を行っている。照射システムを高度化するために ^{57}Ni 放射能強度分布計測を通して測定したコンバータ下流 3 cm の標的上での制動放射線の空間的なサイズは $\sigma = 3.85$ mm (水平)、 $\sigma = 3.61$ mm (垂直)、角度広がり は 54 mrad (水平)、49 mrad (垂直)であった。照射位置で標的 $\Phi 1$ cm に対する空間的な照射効率は 57%と求められ、光子束はおおよそ $1.4\text{E}14[\text{eq.} \cdot \text{q.} \cdot \text{s}^{-1}]$ であった。

ビームエネルギー 50 MeV、タングステン厚み 2 mm、 ^{58}Ni 標的のとき、強度係数は $f = 0.33$ と求められた。今後、巨大共鳴領域に光核反応断面積を持つ安定同位体の内、RI 製造で需要のある Mo や安定同位体が単一で扱いが容易な Co や Au の照射を行い、さらに検討を進める予定である[7][8][9]。

参考文献

- [1] Kikunaga H., “制動放射線照射で製造できる RI”, 東北大学電子光理学研究センター研究会「大強度電子ビームとその応用利用」, Mar. 16-17, 2015.
- [2] Kashiwagi S., “大強度電子加速器と RI 製造”, 東北大学電子光理学研究センター研究会「大強度電子ビームとその応用利用」, Mar. 16-17, 2015.

- [3] Takahashi K., Kashiwagi S., Hinode F., *et al.*, Proceedings of the 12th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan. August 5-7, 2015, Tsuruga, Japan. PASJ2015 WEP004.
- [4] Fultz S.C., Alvarez R.A., Berman B.L., and Meyer P., Photoneutron cross sections of ^{58}Ni and ^{60}Ni , Phys. Rev. C 10 608
- [5] ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー; <http://www.kankyo-hoshano.go.jp/series/lib/No7.pdf>
- [6] Takahashi K., Kikunaga H., Tsukada K., *et al.*, Proceedings of IPAC2016, Busan, Korea, TUPOW011.
- [7] Beil H., Bergere R., Carlos P., Lepretre A., De Miniac A., Veysiere A., A study of the photoneutron contribution to the giant dipole resonance in doubly even Mo isotopes, Nucl. Phys. A227 (1974) 427-449.
- [8] Alvarez R.A., Berman B.L., Faul D.D., Lewis F.H. Jr., and Meyer P., Photoneutron cross sections for ^{55}Mn and ^{59}Co , Phys. Rev. C 20 128.
- [9] Varlamov V.V., Ishkhanov B.S., Orlin V.N., Troshchiev S. Yu., New data for the $^{197}\text{Au}(\gamma, nX)$ and $^{197}\text{Au}(\gamma, 2nX)$ reaction cross sections, Physics, 2010, Vol. 74, No. 6, pp. 842-849.